



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНОЙ МИКРОСХЕМЫ

Номер регистрации (свидетельства):
2017630017

Дата регистрации: 16.01.2017

Номер и дата поступления заявки:
2016630119 31.10.2016

Дата публикации: 16.01.2017

Срок действия исключительного
права истекает: 16.01.2027

Контактные реквизиты:
Добуш Игорь Мирославович;
+79234029286; igadobush@gmail.com

Авторы:

Добуш Игорь Мирославович (RU),
Шеерман Федор Иванович (RU),
Бабак Леонид Иванович (RU)

Правообладатель:

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Томский государственный университет систем
управления и радиоэлектроники» (RU)

Название топологии интегральной микросхемы:

Монолитная интегральная схема SiGe BiCMOS управляемого цифрового аттенюатора диапазона частот 0,1-4,5 ГГц

Реферат:

ИМС представляет собой SiGe монолитную интегральную схему, выполненную на основе 0,25 мкм SiGe BiCMOS технологии. Функционально ИМС является пятиразрядным цифровым аттенюатором с полосой рабочих частот 0,1-4,5 ГГц. Интегральный аттенюатор содержит пять секций ослабления 1 дБ, 2 дБ, 4 дБ, 8 дБ, 16 дБ и цепи компенсации фазовой конверсии. ИМС предназначена для использования в составе приемопередающих СВЧ модулей. Размеры кристалла 1,4x0,6 мм².